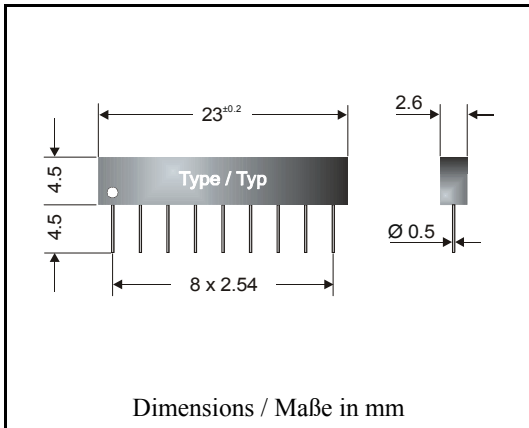
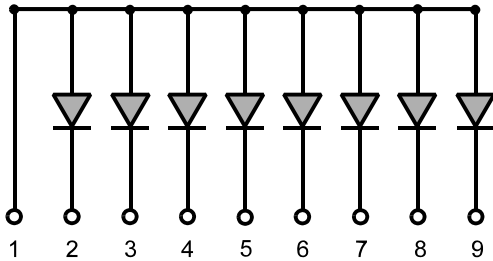


Fast Switching Rectifier Arrays

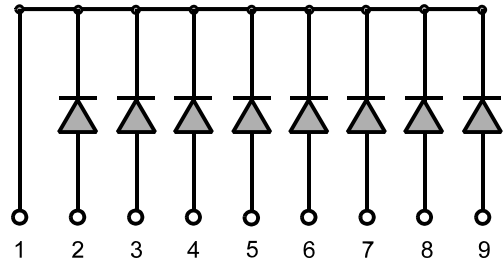
Schnelle Gleichrichter Sätze



| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Nominal power dissipation | 1.2 W |
| Nenn-Verlustleistung | |
| Repetitive peak reverse voltage | 100...400 V |
| Periodische Spitzensperrspannung | |
| 9 Pin-Plastic case | 23 x 2.6 x 4.5 [mm] |
| 9 Pin-Kunststoffgehäuse | |
| Weight approx. – Gewicht ca. | 0.6 g |
| Standard packaging: bulk | see page 22 |
| Standard Lieferform: lose im Karton | s. Seite 22 |



"DA 811 A...8110 A": com. anodes / gem. Anoden



"DA 811 K...8110 K" : com. cathodes / gem. Kathoden

Maximum ratings

Grenzwerte

| Type Typ | Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] | Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] |
|-------------|--|---|
| DAF 811 A/K | 100 | 120 |
| DAF 814 A/K | 400 | 480 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| Max. average forward rectified current, R-load, for one diode operation only per diode for simultaneous operation | $T_A = 25^\circ C$ | I_{FAV} 600 mA ¹⁾ I_{FAV} 150 mA ¹⁾ |
| Dauergrenzstrom in Einwegschtaltung mit R-Last, für eine einzelne Diode pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb | $T_U = 25^\circ C$ | I_{FAV} 600 mA ¹⁾ I_{FAV} 150 mA ¹⁾ |
| Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle | $T_A = 25^\circ C$ | I_{FSM} 30 A |

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

| | | | |
|---|--------------------------|------------------|---------------------|
| Max. power dissipation – Verlustleistung | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | P_{tot} | 1.2 W ¹⁾ |
| Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur | | T_j | - 50...+150 °C |
| Storage temperature – Lagerungstemperatur | | T_S | - 50...+150 °C |

Characteristics

Kennwerte

| | | | | |
|---|---|--|------------------|--|
| Forward voltage Durchlaßspannung | $T_j = 25^\circ\text{C}$ | $I_F = 1\text{ A}$ | V_F | < 1.3 V |
| Leakage current Sperrstrom | $T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$ | $V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$ | I_R I_R | < 10 μA < 90 μA |
| Reverse recovery time Sperrverzug | | $I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to/auf $I_R = 1\text{ mA}$ | t_{rr} | < 350 ns |
| Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft | | | R_{thA} | < 85 K/W ¹⁾ |

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten